

## Market News

### **CoolMOS™ P7 im SOT-223-Gehäuse kombiniert gute Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit einer kostengünstigen Gehäuse-Lösung**

München, 22. August 2017 – Die Infineon Technologies AG erweitert die kürzlich vorgestellte Technologie CoolMOS™ P7 um ein SOT-223-Gehäuse. Der Baustein gleicht bei der Grundfläche dem DPAK-Gehäuse und ersetzt diese Bauform eins-zu-eins. Die Kombination der neuen CoolMOS P7-Plattform mit dem SOT-223-Gehäuse eignet sich ideal für Anwendungen wie [Ladegeräte für Smartphones](#) und [Laptops](#), sowie [Stromversorgung für TV-Geräte](#) und [Beleuchtung](#).

Der neue CoolMOS P7 ist auf die Bedürfnisse des Marktes für SMPS mit geringer Leistung abgestimmt. Es bietet hervorragende Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit; Designer können damit die Vorteile verbesserter Formfaktoren nutzen. Der P7 basiert auf der wettbewerbsfähigen Superjunction-Technologie, die auf Kundenseite die Gesamtkosten (BOM) reduzieren.

Das SOT-223-Gehäuse ist eine kostengünstige Alternative zum DPAK und deshalb gerade in preissensiblen Märkten sehr gut etabliert. Der CoolMOS P7 zeigt auch in diesem Gehäuse gute thermische Eigenschaften; das haben Tests über mehrere Anwendungen hinweg ergeben. Wird das SOT-223 auf einer DPAK-Grundfläche eingesetzt, erhöht sich die Temperatur im Vergleich zu einem Standard-DPAK um maximal 2-3° C. Ist die Kupferfläche 20 mm<sup>2</sup> und größer, dann ist die thermische Leistung des SOT-223 gleich dem des DPAK.

### **Verfügbarkeit**

Der CoolMOS P7 im SOT-223-Gehäuse ist ab sofort verfügbar in den Spannungsklassen 600 V, 700 V und 800 V. Weitere R<sub>DS(on)</sub>-Varianten in 700 V und 800 V werden bald folgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter [www.infineon.com/p7](http://www.infineon.com/p7) und [www.infineon.com/sot-223](http://www.infineon.com/sot-223).